



汕头华汕电子器件有限公司

PNP SILICON TRANSISTOR

9012 晶体管芯片说明书

芯片简介

芯片尺寸：4 英寸（100mm）

芯片代码：A047BJ-00

芯片厚度：240±20μm

管芯尺寸：470×470μm²

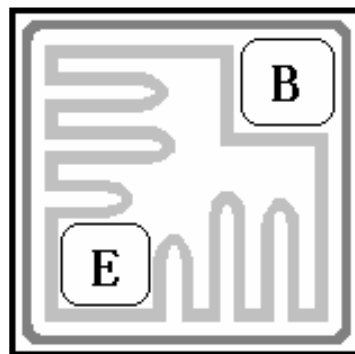
焊位尺寸：B 极 103×103μm²，E 极 98×98μm²

电极金属：铝

背面金属：金

典型封装：SS9012，H9012，8550S

管芯示意图



极限值（T_a=25℃）（封装形式：TO-92）

T_{stg}——贮存温度…………… -55~150℃

T_j——结温……………150℃

P_C——集电极耗散功率……………625mW

V_{CBO}——集电极—基极电压……………-40V

V_{CEO}——集电极—发射极电压……………-20V

V_{EBO}——发射极—基极电压……………-5V

I_C——集电极电流……………-700mA

电参数（T_a=25℃）（封装形式：TO-92）

参数符号	符 号 说 明	最小值	典型值	最大值	单位	测 试 条 件
I _{CBO}	集电极—基极截止电流			-0.1	μA	V _{CB} =-25V, I _E =0
I _{EBO}	发射极—基极截止电流			-0.1	μA	V _{EB} =-3V, I _C =0
h _{FE}	直流电流增益	80		390		V _{CE} =-1V, I _C =-50mA
		40				V _{CE} =-1V, I _C =-500mA
V _{CE(sat)}	集电极—发射极饱和电压			-0.6	V	I _C =-500mA, I _B =-50mA
V _{BE(sat)}	基极—发射极饱和电压			-1.2	V	I _C =-500mA, I _B =-50mA
V _{BE(on)}	基极—发射极导通电压	-0.6		-0.73	V	V _{CE} =-1V, I _C =-10mA
BV _{CBO}	集电极—基极击穿电压	-40			V	I _C =-100μA, I _E =0
BV _{CEO}	集电极—发射极击穿电压	-20			V	I _C =-1mA, I _B =0
BV _{EBO}	发射极—基极击穿电压	-5			V	I _E =-100μA, I _C =0